

## Взаимная ориентационная динамика стабилизированных радикалов $\text{CH}_3$ и матричных молекул $\text{CH}_4$ в твёрдом метане в температурном диапазоне 1.4–35 К

© Ю.А. Дмитриев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе,  
Санкт-Петербург, Россия

e-mail: dmitriev.mares@mail.ioffe.ru

Поступила в редакцию 28.04.2025 г.

В окончательной редакции 03.07.2025 г.

Принята к публикации 24.10.2025 г.

Представлены результаты опытов по стабилизации метильных радикалов  $\text{CH}_3$  из газовой фазы в матрице твёрдого метана  $\text{CH}_4$  и изучению их методом ЭПР. В первой серии опытов образцы, полученные осаждением на подложку при  $T_{\text{деп}} = 4.2$  К, исследованы в температурном диапазоне  $T_{\text{тес}} = 1.4 - 4.2$  К. Во второй серии опытов соответствующие характерные температуры подложки были в пределах:  $T_{\text{деп}} = 15 - 17$  К,  $T_{\text{тес}} = 6.3 - 35.2$  К. Измерена относительная интенсивность запрещённых электрон-ядерных переходов в зависимости от микроволновой мощности и температуры образца. Анализ экспериментальных результатов свидетельствует о наличии двух температурных диапазонов с различной степенью корреляции ориентационного движения радикала и матричных молекул.

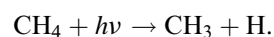
**Ключевые слова:** электронный парамагнитный резонанс, матричная изоляция, метильный радикал, твёрдый метан, вращение молекул.

DOI: 10.61011/OS.2025.10.61936.7915-25

Метильные радикалы  $\text{CH}_3$ , стабилизированные в матрице твёрдого метана  $\text{CH}_4$ , представляют собой систему „квантовый ротатор в матрице квантовых ротаторов“ даже при температурах образца, значительно больших гелиевых. Это является следствием малости вращательной постоянной,  $B = 6.76$  К, для вращения вокруг оси третьего порядка  $C_3$  свободной молекулы, в результате чего расстояние по энергии между нижними вращательными состояниями составляет около 20 К. Для описания квантового ротатора в жидких и твёрдых средах квантовых частиц недавно была предложена [1] и активно развивается [2,3] модель новой квазичастицы — ангулона, представляющего примесную молекулу как частицу — ротатор в „шубе“ из фононов или других многочастичных возбуждённых состояний матричной среды, обладающих угловым моментом [3]. До настоящего времени единственными экспериментами, на которых базируется эта модель, являются опыты по захвату молекул в наноклапты сверхтекучего гелия. В твёрдом метане в качестве многочастичных возбуждённых состояний могут, в частности, выступать квазичастицы топоны — коллективные ориентационные движения молекул, существование которых было предложено для описания особенностей температурного поведения удельной теплоёмкости твёрдого  $\text{CH}_4$  [4] и нашло косвенное подтверждение в особенностях ориентационного движения  $\text{CH}_3$  в матрице  $\text{CD}_4$  [5].

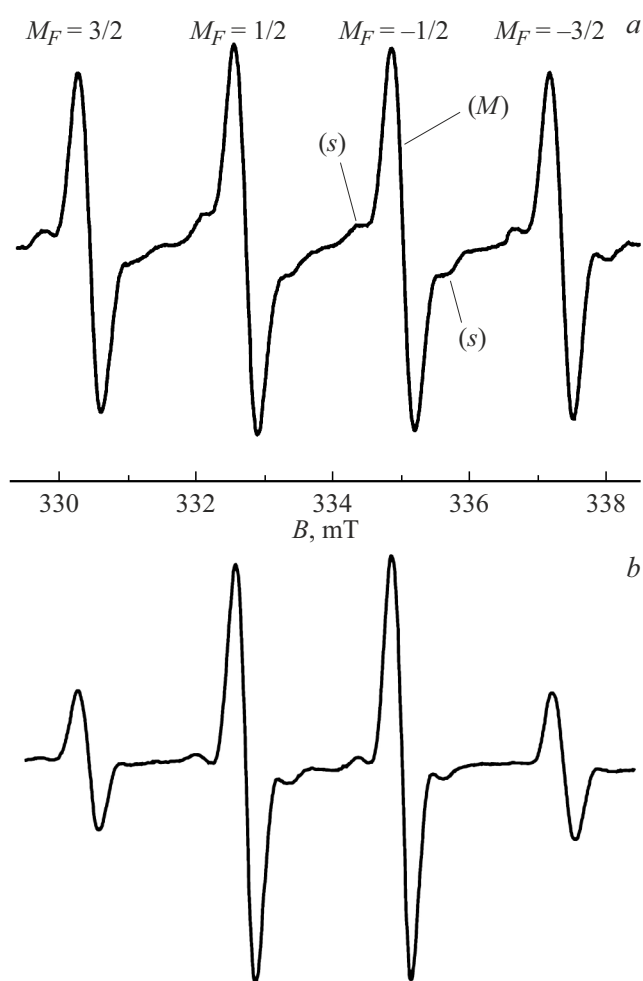
Из прикладных значений системы  $\text{CH}_3/\text{CH}_4$  можно выделить её роль в химических процессах, протекающих в холодных облаках в межзвездном пространстве, на

поверхности комет и в атмосфере планет Солнечной системы и их спутников. Стартовым этапом для последующей цепочки низкотемпературных химических реакций в твёрдом метане с выходом тяжёлых углеводородов является фотолиз метана [6]:



Этан, который является вторым по распространённости в атмосферах планет и космическом пространстве углеводородом после  $\text{CH}_4$ , эффективно образуется при низких температурах в реакции  $2\text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ . Отметим также роль твёрдого метана как перспективного холодного замедлителя нейтронов, радиационная стойкость которого под нейтронным пучком ограничивается образованием определённого количества радиолитического водорода и „замороженных“ радикалов, включая метильные [7].

В настоящей работе получило развитие ЭПР-исследование обнаруженной ранее корреляции ориентационного движения метильного радикала, стабилизированного в диапазоне температур 1.4 – 4.2 К, с ориентационным движением молекул матрицы  $\text{CH}_4$  ( $\text{CD}_4$ ) [8,9]. Измеренная при гелиевых температурах [8] относительная интенсивность запрещённых электронно-ядерных переходов радикалов предполагает определённую предпочтительную ориентацию соседних молекул  $\text{CH}_4$  по отношению к примесной молекуле  $\text{CH}_3$  в А-симметричном состоянии, сохраняющуюся в динамике их взаимного ориентационного движения.

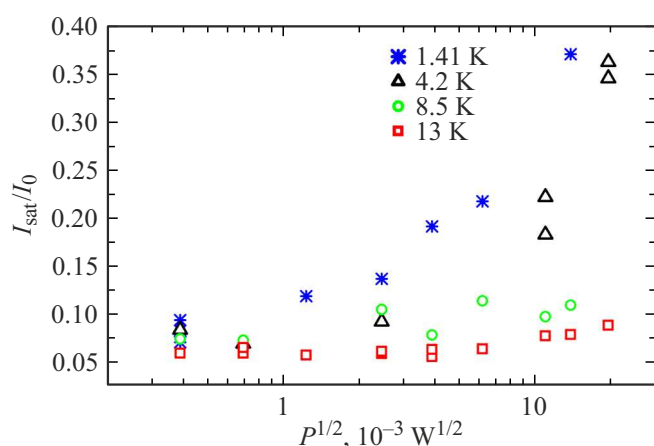


**Рис. 1.** Спектр ЭПР радикала  $\text{CH}_3$ , стабилизированного в матрице твёрдого  $\text{CH}_4$ . (a) Низкотемпературный образец получен осаждением из газовой фазы на подложку при  $T_{\text{dep}} = 4.2$  К. Экспериментальный спектр записан при температуре  $T_{\text{rec}} = 1.73$  К и мощности электромагнитной волны, поступающей в СВЧ резонатор, равной  $0.15 \mu\text{W}$ . Резонансная частота спектрометра  $f_{\text{res}} = 9359.20$  МГц. Здесь  $s$  — запрещённые переходы, проявляющиеся как сателлиты разрешённого перехода  $M$ . (b) Высокотемпературный образец получен и исследован при следующих экспериментальных параметрах:  $T_{\text{dep}} = 15 - 17$  К,  $T_{\text{rec}} = 29.9$  К, микроволновая мощность  $0.15 \mu\text{W}$ . Для удобства сравнения записей положение высокотемпературного спектра в магнитном поле пересчитано к резонансной частоте  $9359.20$  МГц.

На рис. 1, *a, b* представлены экспериментальные спектры ЭПР радикала  $\text{CH}_3$ , стабилизированного в матрице твёрдого  $\text{CH}_4$  осаждением из газовой фазы, записанные при температурах образца соответственно 1.73 и 29.9 К. Первый из этих спектров был получен в серии низкотемпературных экспериментов с осаждением на подложку при 4.2 К, находящуюся в центре вакуумированного СВЧ резонатора, смеси газообразного метана, подаваемого по матричному каналу, и продуктов высокочастотного газового разряда в метане из отдельной

разрядной трубки. Второго спектра (рис. 1, *b*) получен в серии высокотемпературных экспериментов, в которых через разряд пропускалась смесь  $\text{CH}_4/\text{He}$  (2:25), а по матричному каналу подавался чистый метан. Осаждение происходило на подложку при  $T_{\text{dep}} = 15 - 17$  К. Спектр ЭПР радикала  $\text{CH}_3$  содержит четыре интенсивные линии и представляет собой неразрешённую суперпозицию квартета и дублета сверхтонких компонент, являющихся первыми производными линий поглощения. Симметричные ядерные спиновые  $A$ -состояния (полный ядерный спин равен  $3/2$ ) дают в спектре ЭПР сверхтонкий квартет, а антисимметричные  $E$ -состояния (полный ядерный спин равен  $1/2$ ) — дублет. Положения линий дублета в магнитном поле практически совпадают с положениями двух центральных линий квартета, что при ширине линии около  $0.35$  мТ приводит к тому, что эти два мультиплета не разрешаются в спектре. На рис. 1, *a* обозначение ( $M$ ) соответствует разрешённым переходам, а ( $s$ ) — слабым резонансным сателлитным линиям, связанным с запрещёнными электронно-ядерным переходами с одновременным переворачиванием спина неспаренного электрона и спина ядра соседней матричной молекулы. Преимущественное заселение при низких температурах основного вращательного состояния, являющегося  $A$ -симметричным, отражается в соотношении амплитуд и интенсивностей разрешённых сверхтонких компонент, близком к 1:1:1:1. При высоких температурах заселено не только основное, но и первое возбуждённое  $E$ -симметричное состояние, а также последующие возбуждённые вращательные состояния. Это приводит (рис. 1, *b*) к характерному для высоких температур соотношению интенсивностей 1:3:3:1.

Относительная интенсивность сателлитов определяется, как  $I_{\text{sat}}/I_0$ , где  $I_{\text{sat}}$  — интенсивность сателлита,  $I_0$  — интенсивность разрешённой линии. Относительная интенсивность сателлита даёт возможность получить информацию о количестве ближайших матричных молекул и расстоянии до них [10], а также о преимущественной взаимной ориентации радикала и матричных молекул [8]. При гелиевых температурах существенным обстоятельством, затрудняющим анализ спектров, является гораздо более сильное насыщение разрешённых линий при увеличении СВЧ мощности в резонаторе по сравнению с запрещёнными резонансами. Это может приводить к искажению относительного вклада сателлитов, который должен, таким образом, быть определён из спектров при низких уровнях микроволновой мощности. На рис. 2 изображены измеренные по спектрам отношения  $I_{\text{sat}}/I_0$  в зависимости от корня квадратного из СВЧ мощности в резонаторе для образцов при различных температурах. Из рисунка следует, что функция  $I_{\text{sat}}/I_0(P^{1/2})$  очень чувствительна к температуре и уже при  $T_{\text{rec}} = 8.5$  К близка к константе. Оценочные максимальные значения микроволновой мощности для измерения отношений интенсивностей следующие:  $0.15 \mu\text{W}$  (1.41 К),  $1 \mu\text{W}$  (4.2 К),  $9 \mu\text{W}$  (8.5 К),  $49 \mu\text{W}$  (13 К). Этот результат согласуется

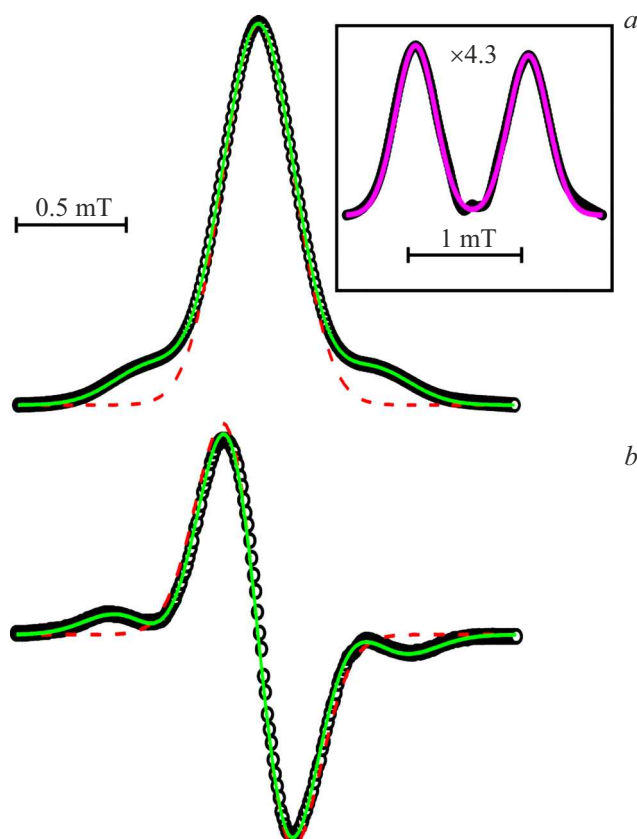


**Рис. 2.** Зависимость относительной интенсивности спутных линий низкочастотной и высокочастотной сверхтонких компонент спектра ЭПР  $\text{CH}_3$  в  $\text{CH}_4$  от СВЧ мощности в резонаторе спектрометра для образцов при различных температурах. Здесь  $I_{\text{sat}}$  — интенсивность спутника,  $I_0$  — интенсивность разрешенной линии. Результаты, обозначенные синими звездочками, соответствуют температуре образца 1.41 К, черными треугольниками — 4.2 К, зелеными кружками — 8.5 К, красными квадратами — 13 К. Наибольшие и наименьшие значения корня квадратного из мощности СВЧ, отложенного по оси абсцисс, получены при мощности соответственно 0.15 и 377  $\mu\text{W}$ .

с соответствующей величиной 10  $\mu\text{W}$ , представленной в работе [10] для образца  $\text{CH}_3$  в  $\text{CH}_4$  при 10 К.

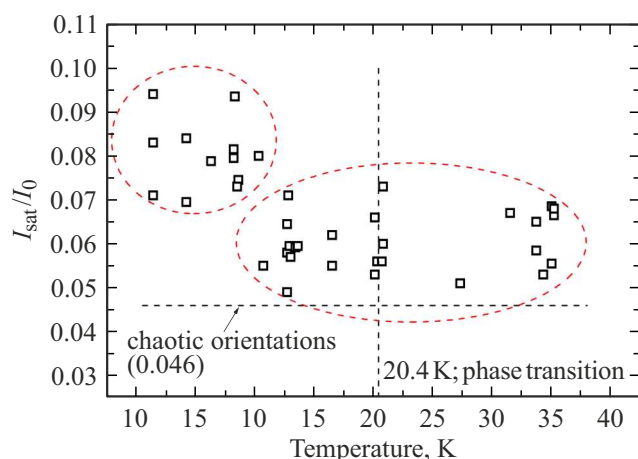
Обработка экспериментального спектра проводилась следующим образом (рис. 3). Интегрированием экспериментальной кривой (черные кружки, рис. 3, *b*) сверхтонкой компоненты, в данном случае  $M_F = -3/2$ , нами была получена резонансная линия поглощения — черные кружки на рис. 3, *a*. Разрешенная линия поглощения моделировалась кривой гауссовой формы (красная штриховая кривая на рис. 3, *a*) и полученной взятием производной от неё (красная штриховая кривая на рис. 3, *b*). Спектр спутников был выделен как разность экспериментальной и расчётной (гауссовой) кривых — черные кружки на вставке на рис. 3, *a*. Спутники промоделированы суперпозицией двух гауссовых линий — пурпурная сплошная кривая. Суперпозиции разрешенного и запрещенных резонансов (сплошные зеленые линии на рис. 3, *a*, *b*) хорошо воспроизводят эксперимент.

Полученные результаты для относительной интенсивности спутников в зависимости от температуры образца изображены на рис. 4. Довольно большой разброс точек на графике объясняется тем, что спутники имеют малую интенсивность и выделяются как результат разности двух величин значительно большей интенсивности: экспериментальной и расчётной. Из рисунка видно, что совокупность экспериментальных значений разбивается на две группы: низкотемпературную и высокотемпературную. Параллельная оси абсцисс штриховая прямая соответствует вкладу спутников в интенсивности резо-



**Рис. 3.** Моделирование высокочастотной,  $M_F = -3/2$ , сверхтонкой компоненты спектра ЭПР радикала  $\text{CH}_3$ . Спектр получен при температуре образца  $T_{\text{rec}} = 8.5$  К и СВЧ мощности в резонаторе, равной 189  $\mu\text{W}$ . (а) Моделирование линии поглощения. Здесь черные кружки — резонансная кривая, полученная интегрированием экспериментального спектра; красная штриховая кривая — расчётная гауссова кривая, моделирующая основную (разрешенную) линию ЭПР; зеленая сплошная кривая — моделирование экспериментального результата суперпозицией основной и спутных линий. На вставке показана с увеличением 4.3 разностная кривая экспериментального (черные кружки) и расчётного (красная штриховая кривая) резонансов, представляющая собой спутный спектр. Моделирование этой разностной кривой представлено пурпурной линией и рассчитано как суперпозиция двух гауссовых резонансных кривых. (б) Моделирование первой производной поглощения. Здесь черные кружки — экспериментальный результат; красная штриховая кривая — расчётная гауссова кривая, моделирующая основную (разрешенную) линию ЭПР; зеленая сплошная кривая — моделирование экспериментального результата суперпозицией основной и спутных линий.

нансной линии при хаотической ориентации соседних к стабилизированному радикалу молекул матрицы [8]. Вертикальная штриховая прямая соответствует температуре (20.4 К) перехода в твёрдом метане от низкотемпературной фазы II с частичным ориентационным упорядочением молекул  $\text{CH}_4$  к высокотемпературной фазе I с отсутствием ориентационного порядка. Различные ориентационные фазы твёрдого  $\text{CH}_4$  и переходы



**Рис. 4.** Зависимость относительной интенсивности спутных линий низкопольной и высокопольной сверхтонких компонент спектра ЭПР  $\text{CH}_3$  в  $\text{CH}_4$  от температуры образца.

между ними были обнаружены по результатам калориметрических исследований, когерентного рассеяния нейтронов, рентгеновского рассеяния, времяпролётной импульсной порошковой нейтронографии, исследований теплопроводности и другим. Фаза II характеризуется наличием восьми подрешёток, в двух из которых молекулярное поле исчезает и молекулы  $\text{CH}_4$ , таким образом, не ориентированы. Шесть из восьми молекул метана ориентационно упорядочены. Кристаллическая структура, соответствующая центрам масс молекул, является гранецентрированной кубической. Низкотемпературная фаза III, соответствующая полной ориентационной упорядоченности молекул, наблюдалась при нулевом давлении только для тяжёлого метана  $\text{CD}_4$  при температуре ниже 22.1 К. В свою очередь, фазовый переход I–II в  $\text{CD}_4$  происходит при температуре 27.0 К. Ранее в опытах по стабилизации  $\text{CH}_3$  в  $\text{CD}_4$  [9] обнаружено, что метильные радикалы, захваченные в низкотемпературной матрице (фаза III), меняют симметрию с планарной  $D_3$ , характерной для свободной молекулы, на пирамидальную  $C_3$ . С увеличением температуры образца и переходами ориентационной структуры матрицы к фазам II и I заметная доля молекул — около 40% в первом случае и 50% во втором случае — восстанавливает планарную структуру. Эти результаты были получены при исследовании температурной зависимости относительной интенсивности разрешённых линий дублета и квартета, изменяющейся в зависимости от населённости вращательных уровней радикала  $\text{CH}_3$ . Следует также отметить драматическое падение вращательной постоянной для  $\text{CH}_3$  в  $\text{CD}_4$ ,  $B = 3.15$  К, в сравнении со значением для свободной молекулы,  $B_{\text{free}} = 6.76$  К. Такое же изменение вращательной постоянной наблюдалось и в опытах при гелиевых температурах по стабилизации  $\text{CH}_3$  в  $\text{CH}_4$  [11]. Из рис. 4 следует, что переход при 20.4 К от фазы I твёрдого  $\text{CH}_4$  к фазе II заметным образом не отражается на взаимной ориентации радикала и мат-

ричных молекул. Этот вывод коррелирует с описанным выше результатом по малому изменению симметрии молекул  $\text{CH}_3$  в  $\text{CD}_4$  при переходе фаза I — фаза II. Что касается скачкообразного изменения относительной интенсивности спутников (рис. 4), то ориентировочная температура этого изменения,  $T_{\text{trans}} = 10$  К, практически равна температуре перехода линейного коэффициента расширения твёрдого  $\text{CH}_4$  от положительных значений к отрицательным [12,13]. Объём ячейки кристалла, таким образом, достигает минимума и сменяется ростом при изменении температуры. Отрицательный линейный коэффициент расширения является характерной особенностью именно лёгкого твёрдого метана  $\text{CH}_4$  и не наблюдается в тяжёлом  $\text{CD}_4$ . Метан  $\text{CH}_4$  является смесью трёх спиновых модификаций  $A$ ,  $T$ ,  $E$  с полным ядерным спином молекул 2, 1, 0 соответственно. Основное вращательное состояние ( $J = 0$ ) имеет  $A$ -симметрию и соответствует наименьшей энергии молекулы. Если время конверсии после осаждения образца в нижние по энергии состояния занимает в чистом метане несколько часов [14], то вблизи парамагнитной примеси, например, радикала  $\text{CH}_3$ , это время сокращается до секунд. Каждая молекула  $\text{CH}_4$  находится в твёрдом метане в кристаллическом поле с несколькими эквивалентными минимумами, между которыми может туннелировать, что приводит к туннельному расщеплению вращательных уровней. При малой высоте барьера расщепление уровней по энергии велико, а с увеличением высоты уменьшается вероятность туннелирования и, следовательно, уменьшается расщепление уровней. Равновесный объём ячейки при данной температуре соответствует минимуму свободной энергии как функции объёма. Вклад в свободную энергию вносят [12,13] туннельные уровни, заселённость которых меняется с температурой, упругая деформация, возбуждения решётки, связанные с либронами и фононами. При низких температурах преимущественный вклад вносят первые две компоненты, определяющие существенно квантовый характер коэффициента линейного расширения и его отрицательное значение в этом диапазоне. При высоких температурах определяющей является третья компонента, приводящая к положительному коэффициенту и его классическому температурному ходу. Таким образом, наблюдаемая в нашем эксперименте граница  $T_{\text{trans}} \sim 10$  К между двумя предпочтительными взаимными ориентациями радикала  $\text{CH}_3$  и соседних молекул  $\text{CH}_4$  соответствует переходу между диапазонами преимущественно квантовой и преимущественно классической природы свободной энергии твёрдого метана.

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] R. Schmidt, M. Lemeshko. *Phys. Rev. Lett.*, **114** (20), 203001 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.203001
- [2] Y.Y. Liu, Y. Cui, X.Z. Shang, R.B. Yang, Z.Q. Li, Z.W. Wang. *J. Chem. Phys.*, **159**, 114305 (2023). DOI: 10.1063/5.0162004
- [3] Z. Zeng, E. Yakaboylu, M. Lemeshko, T. Shi, R. Schmidt. *J. Chem. Phys.*, **158**, 134301 (2023). DOI: 10.1063/5.0135893
- [4] А.Ю. Захаров, А.В. Леонтьева, А.Ю. Прохоров, А.И. Эренбург. *ФТТ*, **56** (7), 1446 (2014).  
<https://journals.ioffe.ru/articles>
- [5] A.Yu. Prokhorov, A.V. Leont'eva, Yu.A. Dmitriev. *J. Phys: Conf. Ser.*, **1352**, 012041 (2019).  
DOI: 10.1088/1742-6596/1352/1/012041
- [6] B. Gans, S. Boyé-Péronne, M. Broquier, M. Delsaut, S. Douin, C.E. Fellows, P. Halvick, J.-C. Loison, R.R. Lucchese, D. Gauyacq. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **13**, 8140 (2011).  
DOI: 10.1039/C0CP02627A
- [7] O. Kirichek, C.R. Lawson, D.M. Jenkins, C.J.T. Ridley, D.J. Haynes. *Cryogenics*, **88**, 101 (2017).  
DOI: 10.1016/j.cryogenics.2017.10.017
- [8] Ю.А. Дмитриев. *Опт. и спектр.*, **132** (11), 1108 (2024).  
DOI: 10.61011/OS.2024.11.59491.6359-24
- [9] Yu.A. Dmitriev, N.P. Benetis. *J. Phys. Chem. A.*, **122**, 9483 (2018). DOI: 10.1021/acs.jpca.8b09478
- [10] F.J. Adrian, B.F. Kim, J. Bohandy. *J. Chem. Phys.*, **82** (4), 1804 (1985). DOI: 10.1063/1.448414
- [11] Ю.А. Дмитриев. *Опт. и спектр.*, **129** (9), 1129 (2021).  
DOI: 10.21883/OS.2021.09.51337.2140-21
- [12] Yu.A. Freiman, V.V. Vengerovsky, A.F. Goncharov, *Fiz. Nizk. Temp.*, **46** (2), 219 (2020). DOI: 10.1063/10.0000537
- [13] Ю.А. Фрейман. *ФНТ*, **9** (6), 657 (1983).
- [14] А.Н. Александровский, В.Б. Кокшенёв, В.Г. Манжелей, А.М. Толкачёв, *ФНТ*, **4** (7), 915 (1978).